

Міністерство освіти і науки України  
Державний вищий навчальний заклад  
«Донбаський державний педагогічний університет»  
Бібліотека

*Серія «Видатні професори університету»  
Вип. 6*

**Віктор Олексійович Надточій**  
(до 75-річчя з дня народження)

**Біобібліографічний покажчик**

Слов'янськ  
2014

Міністерство освіти і науки України  
Державний вищий навчальний заклад  
«Донбаський державний педагогічний університет»  
Бібліотека

*Серія «Видатні професори університету»  
Вип. 6*

**Віктор Олексійович Надточій**  
(до 75-річчя з дня народження)

**Біобібліографічний покажчик**

Слов'янськ  
2014

УДК 016:929+016:53  
ББК 91.9:2+22.3я1  
Н 178

*Рекомендовано до друку вченою радою  
(протокол № 1 від 09.10.2014 року)*

Упорядники: Золотарьова О. М., Гайко О. К.

Науковий редактор Нечволод М. К., д-р фіз.-мат. наук, професор

Відповідальний за випуск Качина В. С.

Віктор Олексійович Надточій : біобібліографічний покажчик / ДВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т"; упоряд. : Золотарьова О. М., Гайко О. К.; наук. ред. Нечволод М. К. – Слов'янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2014. – с.

Матеріали біобібліографічного покажчика із серії «Видатні професори Донбаського державного педагогічного університету» присвячено Віктору Олексійовичу Надточію – відомому вченому, досліднику, доктору фізико-математичних наук, професору.

У покажчику подано бібліографію наукових праць вченого з 1969 по 2014 рр., розміщено матеріали про наукову школу В. О. Надточія, а також літературу про життя та діяльність видатного вченого і педагога.

Покажчик рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, бібліотекарям, усім, хто цікавиться питаннями сучасної фізичної науки, педагогічної практики.



Майбутнє в усіх сферах людської діяльності  
в значній мірі буде визначатися досягненнями  
в області квантової фізики і наноелектроніки

*Віфм*

## Від упорядників

Шостий випуск покажчика серії «Видатні професори університету» присвячено Віктору Олексійовичу Надточію, доктору фізико-математичних наук, професору Донбаського державного педагогічного університету ( до 2011 року – Слов'янського державного педагогічного університету).

У біобібліографічному покажчику представлена бібліографія праць вченого, які були надруковані упродовж 45 років науково-педагогічної діяльності з 1969 по 2014 рік. Це статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації в періодичних виданнях, автореферати дисертацій, депоновані наукові праці, патенти, авторські свідоцтва.

Покажчик складається з: передмови, вступної статті, основних дат життя і діяльності та трьох основних розділів: Розділ I. Праці В. О. Надточія; Розділ II. Наукова школа вченого В. О. Надточія; Розділ III. Література про життя та діяльність.

Розділ I. містить бібліографічні описи праць, які згруповано і розміщено в хронологічному порядку – за прямою хронологією з відокремленням років видання, а в межах року – за видами документів: статті та інші матеріали з неперіодичних видань та продовжуваних видань, в т. ч. із журналів; дисертації, автореферати дисертацій, депоновані наукові праці, патенти, авторські свідоцтва українською, російською (порядок розташування за зведеним українсько-російським алфавітом), іноземними мовами

Розділ II. містить бібліографічні описи дисертацій та авторефератів дисертацій під науковим керівництвом В. О. Надточія. Матеріал згруповано за прямою хронологією.

Розділ III містить бібліографічні описи видань про життєвий і творчий шлях. Матеріал згруповано за видами документів.

Бібліографічні записи в покажчику мають суцільну нумерацію.

Допоміжний апарат біобібліографічного покажчика включає:

- іменний покажчик прізвищ авторів, співавторів, упорядників, редакторів;
- алфавітний покажчик назв праць В. О. Надточія.

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено за чинними в Україні стандартами. Джерелами відбору документів були каталоги і картотеки бібліотеки ДДПУ, бібліографічні джерела та матеріали, надані вченим. Більшість публікацій, що увійшли до покажчика, було переглянуто *de visu*.

Покажчик адресовано широкому колу науковців та педагогічних працівників, аспірантам, студентам, бібліотекарям, та всім, хто цікавиться проблемами нанотехнологій, сучасних фізичних досліджень, практики педагогічної науки.

## Безкомпромісні пошуки наукової істини

7 листопада 2014 року виповнюється 75 років від дня народження Віктора Олексійовича Надточія – доктора фізико-математичних наук, професора Донбаського державного педагогічного університету, талановитого педагога, винахідника, професіонала високого рівня.

Надточій Віктор Олексійович народився 7 листопада 1939 року в багатодітній сім'ї в місті Полонне Хмельницької області.

У 1957 році закінчив Львівський технікум електрозв'язку, працював техніком радіозв'язку, військову службу відбував у ракетних військах.

У 1961 році вступив і в 1966 році закінчив радіотехнічний факультет Харківського політехнічного інституту зі спеціальності радіоелектроніка, і отримав кваліфікацію радіоінженера.

Після закінчення вузу у 1966 році, як один із кращих випускників, був прийнятий на посаду старшого викладача кафедри фізики Слов'янського державного педагогічного інституту (з 2002 року державного педагогічного університету), де плідно, талановито і творчо працює вже майже півстоліття.

Віктор Олексійович за ці 50 років роботи у нашому вузі пройшов славний і дуже нелегкий творчий шлях: старший викладач кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 30 років завідувач кафедри фізики, доктор фізико-математичних наук, професор.

Разом з доктором фізико-математичних наук, професором, академіком, проректором з навчальної і наукової роботи, ректором інституту (згодом університету) Миколою Кузьмичем Нечволодом Віктор Олексійович Надточій вперше в світі започаткував створення і подальше успішне наукове дослідження та розробку в інституті зовсім нового надзвичайно важливого для подальшого науково-технічного прогресу наукового напрямку «Низькотемпературна мікропластичність алмазоподібних напівпровідників та її вплив на електричні параметри». Саме вони являються основою сучасної і майбутньої електронної техніки, пов'язаною з розробкою і впровадженням нових квантових - так званих нанотехнологій. В інституті вперше були створені наукові лабораторії з фізики твердого тіла і фізики напівпровідників, які успішно працюють. Результати наукових досліджень, одержаних у вказаних лабораторіях, дозволяють створювати кристалічні матеріали (метали, сплави, діелектрики, квантові напівпровідники) з підвищеним комплексом фізичних властивостей (електричних, механічних, теплових, оптичних та інших).

Це надзвичайно важливо для подальшого науково-технічного прогресу. Зокрема, розробка і впровадження квантових технологій, дають можливість створення в мікрооб'ємах (розміром в десятки міліметрів) тисячі і більше транзисторів та інших електронних напівпровідникових пристроїв.

У Слов'янському педагогічному університеті при кафедрі фізики була створена і успішно працює наукова школа з фізики твердого тіла і фізики напівпровідників, яку зараз очолює доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики Надточій Віктор Олексійович.

По результатах цих, широко відомих у нашій країні і за її межами наукових досліджень, Віктор Олексійович успішно захистив під науковим керівництвом професора М. К. Нечволода кандидатську, а згодом і докторську дисертацію у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, має більше 140 наукових публікацій, систематично запрошується з доповідями на вітчизняні та зарубіжні наукові конгреси, зокрема виступав у Німеччині, Польщі та інших країнах. Одержав два державні патенти на винаходи, пов'язані із створенням і впровадженням в сучасну і майбутню електронну техніку особливих (на атомному рівні) нанотехнологій. Під його науковим керівництвом були успішно захищені дві кандидатські дисертації його аспірантів, виконано і захищено цілий ряд дипломних і магістерських студентських робіт.

В. О. Надточій вперше в нашому вузі створив також навчальні лабораторії радіоелектроніки, фізики напівпровідників і нанотехнологій. На високому науковому і педагогічному рівні він читає лекції, проводить практичні і лабораторні учбові заняття, керує кафедрою фізики. Має великий авторитет і повагу з боку викладачів, студентів і аспірантів, всього колективу Донбаського державного педагогічного університету, а також у нашій країні і за її межами.

І в тому, що Слов'янський державний педагогічний інститут одержав по результатах атестації найвищий (магістерський) статус державного університету є дуже значна заслуга і професора Віктора Олексійовича Надточія, кафедри фізики, колективу фізики-математичного факультету, як і всього колективу вузу.

Випускники, аспіранти, магістранти В.О Надточія, як і всього нашого університету, успішно працюють в нашій країні і за кордоном.

Все свідоме життя Віктора Олексійовича – це натхненний, творчий пошук. Він всебічно обдарована, талановита людина. Любить поезію, літературу (в тому числі філософські етюди) і класичну музику.

Дуже любить природу, зоряне небо, під яким часто вечорами розмірковує в творчих пошуках наукової істини у вирішенні надзвичайно складних проблем.

Всесвітньо відомий вчений, лауреат Нобілевської премії Альберт Ейнштейн на 100-річному ювілеї Макса Планка, теж всесвітньо відомого вченого, засновника квантової механіки на засіданні Академії наук сказав: «У науці є три категорії вчених. Перша категорія – це пошуки матеріальних благ, друга – честолюбство, а треті одержимі тільки безкомпромісними пошуками наукової істини». Далі він зауважив: «Якщо із храму науки вигнати перші дві категорії – він би катастрофічно став пустим. Залишилися б тільки одиниці. І навіть серед цих одиниць, що залишилися, промовив Ейнштейн, – на перше місце я поставив би Макса Планка».

Я впевнений, що до цієї нечисленної третьої категорії вчених в повній мірі можна віднести і доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри фізики Донбаського державного педагогічного університету Віктора Олексійовича Надточія – невпинного пошукувача наукових істин.

За особливі досягнення В. О. Надточій відзначений багатьма урядовими і почесними нагородами.

Віктор Олексійович має чудових дружину Раїсу, доньку Ларису, онука Єлізара.

Натхнений, працьовитий і невтомний  
В житті ти йдеш буремно, невгамовно,  
І з вогником душі, що не погас  
Хай буде все гаразд!

Буремні хащі квантових вібрацій  
І обертонівських частот  
І дислокацій, дисклінацій  
З краудіонівських висот

Ти розгортаєш по напругам  
І довжині дифузних хвиль  
І всупереч всім зовнішнім наругам  
Ти в 75 ще зовсім молодий!!!

Тож хай цей вогник не згасає  
Бажання буде так палке,  
Щоб в думці з подивом зринало:  
«А що таке?! А що таке?!»

Життєві істини, не тільки наукові  
Хай розгортаються тобі  
Знахідки будуть пошукові  
В сім'ї, роботі і... в собі !

*М. К. Нечволод – почесний ректор Донбаського держ. пед. ун-ту,  
радник ректора, доктор фізико-математичних наук, професор.*



## **Основні дати життя та діяльності В. О. Надточія**

**1939 р., 7 листопада** – народився у Хмельницької області, м. Полонне.

**1953 р.** – закінчив Правохоромрянську середню школу Полонського району.

**1953–1957 р.** – навчання у Львівському електротехнікумі зв'язку.

**1958 р., травень** – початок трудової діяльності на посаді техника Ярмолинецької контори зв'язку.

**1958–1961** – служба у лавах Радянської армії.

**1961–1966 рр.** – навчання на радіотехнічному факультеті Харківського політехнічного інституту ім. В. І. Леніна.

**З вересня 1966 р.** – працює старшим викладачем у Слов'янському державному педагогічному інституті.

**1975 р.** – захистив кандидатську дисертацію в Інституті металофізики АН УРСР на тему "Дослідження закономірностей низькотемпературної мікропластичної деформації монокристалічного германію і кремнію".

**1976 р.** – присуджено звання доцента, з жовтня переведений на посаду доцента кафедри фізики СДПІ.

**З 1984 р.** – займає посаду зав. кафедри фізики СДПІ.

**1999 р.** – нагороджений Грамотою МОН України та знаком "Відмінник освіти України" (наказ Міністра освіти № 452 від 08.07.1999 р.).

**2001 р., жовтень** – зарахований до докторантури СДПІ.

**2004 р.** – нагороджений Почесною грамотою Донецької обласної державної адміністрації.

**2007 р.** – захистив докторську дисертацію при Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна зі спеціальності 01.04.07. – фізика твердого тіла на тему "Мікропластичність алмазоподібних кристалів (Si, Ge, GaAs, InAs)", присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук.

**2007 р., липень** – нагороджений Почесною грамотою МОН України.

**2008 р., 23 грудня** – присвоєно вчене звання професора.

**З 2009 р.** – заідувач кафедри фізики, професор Слов'янського державного педагогічного університету.

**2012–2013 рр.** – отримано два патента на винахід: № 97999 "Спосіб визначення міри дефектності приповерхневих шарів монокристалів германію або кремнію" і № 101705 "Спосіб створення наноструктур на поверхні германію".

**З 2012 р.** – завідувач кафедри фізики, професор Донбаського державного педагогічного університету.

## Розділ І. Праці В. О. Надточія

### 1969

1. Дислокационная структура монокристаллов LiF в условиях резких термических изменений / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод // Укр. физ. журнал. – 1969. – Т. 14. – № 6. – С. 1046–1049.

### 1970

2. Измерение ЭДС Холла на переменных электрических и магнитных полях / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод // Приборы и техника эксперимента. – 1970. – № 2. – С. 167–168.

### 1973

3. Некоторые закономерности ступенчатой ползучести монокристаллического германия и кремния при комнатной температуре / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, В. П. Алехин, М. Х. Шоршоров // Дефекты структуры в полупроводниках : материалы Всесоюз. совещ., 2–4 окт. 1973 г. – Новосибирск, 1973. – С. 138–141.

4. О пластической деформации германия и кремния при комнатной температуре в условиях одноосного сжатия / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, М. Х. Шоршоров // Дефекты структуры в полупроводниках : материалы Всесоюз. совещ. 2–4 окт. 1973 г. – Новосибирск, 1973. – С. 142–145.

5. О применимости теории упрочнения к описанию единства закономерностей деформирования в различных условиях одноосного растяжения / А. П. Тихонов, В. А. Надточий // Проблемы прочности. – 1973. – № 5. – С. 58–61.

### 1974

6. Некоторые закономерности ступенчатой ползучести монокристаллического германия при 300 К / В. А. Надточий, В. П. Алехин, Н. К. Нечволод // Физика и химия обработки материалов. – 1974. – № 5. – С. 112–119.

7. О закономерностях пластической деформации кремния при комнатной температуре / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, В. П. Алехин, М. Х. Шоршоров // Физика и химия обработки материалов. – 1974. – № 6. – С. 103–108.

8. О пластической деформации германия при комнатной температуре / В. А. Надточий, В. А. Алехин, Н. К. Нечволод, А. П. Тихонов, М. Х. Шоршоров // Физика и химия обработки материалов. – 1974. – № 3. – С. 83–90.

9. Установка для исследования ползучести алмазоподобных полупроводниковых материалов при комнатной температуре / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, А. П. Тихонов // Заводская лаборатория. – 1974. – Т. 40. – № 1. – С. 112–114.

### 1975

10. Особенности низкотемпературной микропластической деформации германия в условиях одноосного сжатия / Н. К. Нечволод, В. П. Алехин, В. А. Надточий // Сплавы редких металлов с особыми физическими свойствами : материалы II Всесоюз. совещ. – М., 1975.

11. Особенности низкотемпературной микропластической деформации кремния при комнатной температуре / Н. К. Нечволод, В. П. Алехин, В. А. Надточий, М. Х. Шоршоров // Сплавы редких металлов с особыми физическими свойствами : материалы II Всесоюз. совещ. – М., 1975. – С. 72–76.

12. Исследование закономерностей низкотемпературной микропластической деформации монокристаллического германия и кремния : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Надточий Виктор Алексеевич; Ин-т металлофизики АН УССР. – К., 1975. – 160 с.

13. Исследование закономерностей низкотемпературной микропластической деформации монокристаллического германия и кремния : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Физика твердого тела" / В. А. Надточий; Ин-т металлофизики АН УССР. – К., 1975. – 26 с.

### 1976

14. О пластической деформации Ge и Si при комнатной температуре в условиях одноосного сжатия / В. П. Алехин, В. А. Надточий, Н. К. Нечволод // Металлические монокристаллы. Получение и исследование свойств / АН СССР, Ин-т металлургии им. А. А. Байкова. – М., 1976. – С. 180–185.

15. Особенности микропластической деформации германия в условиях одноосного сжатия при комнатной температуре / В. П. Алехин, В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, М. Х. Шоршоров // Металлические монокристаллы. Получение и исследование свойств / АН СССР, Ин-т металлургии им. А. А. Байкова. – М., 1976. – С. 186–193.

### 1977

16. Низкотемпературная деформация в монокристаллах Ge и Si / М. Х. Шоршоров, В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, В. П. Алехин, А. З. Калимбет, В. П. Вареца // Монокристаллы тугоплавких и редких металлов, сплавов и соединений. – М., 1977. – С. 150–156.

### 1978

17. Неконсервативное движение ростовых дислокаций в макрообразцах и нитевидных кристаллах Ge и Si в условиях одноосного сжатия при 20° С / В. П. Алехин, В. А. Надточий, В. В. Господаревский, М. Х. Шоршоров // Дефекты структуры в полупроводниках : материалы III Всесоюз. совещ., 27–29 нояб. 1978 г. – Новосибирск, 1978. – Ч. 1. – С. 31.

18. Структурно-кинетические закономерности движения дислокаций в монокристаллах Ge и Si в низкотемпературном интервале 20-300 К / В. А. Надточий, А. З. Калимбет // Вісник АН УРСР. – 1978. – № 7.

### 1985

19. Влияние низкотемпературной микропластической деформации на электрические свойства кремниевых p-n переходов / В. А. Надточий, А. З. Калимбет, В. П. Алехин, А. Я. Белошапка // Физика и химия обработки материалов. – 1985. – № 1. – С. 115–120.

### 1988

20. Важный результат повышения качества профессиональной подготовки выпускника педвуза / В. А. Надточий, Р. В. Олейник // Психологические условия профессионального становления личности в свете реформы общеобразовательной и профессиональной школы : тез. науч. конф. – М., 1988. – Ч. 1, разд. 1. – С. 76–77.

21. Расчет дислокационных донорных уровней в щелочно-галогидных кристаллах на основе экспериментальных данных о низкотемпературной ползучести / Н. К. Нечволод, В. А. Надточий, В. А. Золотухин // Физика твердого тела : сб. / Донецкий гос. ун-т. – К.; Донецк, 1988. – Вып. 18. – С. 60–62.

### 1990

22. Пути реализации проблемного обучения на лекциях / Л. С. Шурыгина, В. А. Надточий // Методологические, дидактические и психологические аспекты проблемного обучения физике : тез. докл. Всесоюз. науч.-метод. конф., 3–5 сент. 1990 г. – Донецк, 1990. – С. 134–136.

### 1991

23. Об эффективности использования проблемного обучения на подготовительном отделении / В. Н. Рыбенцев, В. А. Надточий // Методологические, дидактические и психологические аспекты проблемного обучения физике : тез. докл. 2-ой Всесоюз. науч.-метод. конф., 2–4 сент. 1991 г. – Донецк, 1991. – С. 95–96.

24. Психологические основы творчества и проблемное обучение / Л. С. Шурыгина, В. А. Надточий // Методологические, дидактические и психологические аспекты проблемного обучения физике : тез. докл. 2-ой Всесоюз. науч.-метод. конф., 2–4 сент. 1991 г. – Донецк, 1991. – С. 18–19.

### 1992

25. Ток в точечном контакте полупроводника с дефектным поверхностным слоем / Н. Н. Голоденко, В. А. Надточий, Б. А. Свиридюк; Славянский гос. пед. ин-т. – Славянск, 1992. – 24 с. – Деп. в УкрИНТЭИ 09.06.92, № 852. – Ук. 92.

### 1993

26. Автоматизированная установка на базе микро-ЭВМ для определения концентрации примесей в полупроводниках / В. А. Надточий, В. Н. Ткаченко, Л. С. Шурыгина // Компьютерные программы учебного назначения : тез. докл. I Междунар. конф., 3–5 сент. 1993 г. – Донецк, 1993. – С. 270–271.

27. Дослідження поверхневої міграції вакансій в напівпровідниках германію в осцилюючому полі механічних напружень / Ю. М. Гриценко, В. О. Надточій, М. К. Нечволод // Актуальні проблеми сучасної науки : тези доп. наук. конф. викл. та студ. Слов'янського держ. пед. ін-ту. – Слов'янськ, 1993. – С. 9–10.

28. Методика викладання теми "Просторова когерентність" / М. М. Голоденко, В. О. Надточій, М. К. Нечволод // Актуальні проблеми сучасної науки : тези доп. наук. конф. викл. та студ. Слов'янського держ. пед. ін-ту. – Слов'янськ, 1993. – С. 110–111.

29. О низкотемпературной ступенчатой ползучести кристаллических тел как фрактальном физическом процессе / Ю. Н. Гриценко, В. А. Надточий, Н. К. Нечволод // Актуальні проблеми сучасної науки : тези доп. наук. конф. викл. та студ. Слов'янського держ. пед. ін-ту. – Слов'янськ, 1993. – С. 10-11.

### 1994

30. Информатизация системы образования как условие совершенствования его содержания / В. А. Надточий, Л. С. Шурыгина, Н. Н. Голоденко // Комп'ютерні програми учбового призначення : тези доп. II Міжнар. конф. – Донецьк, 1994. – С. 35.

31. Численный эксперимент в радиоэлектронике / В. А. Надточий, Н. Н. Голоденко, Ю. Н. Гриценко // Комп'ютерні програми учбового призначення : тези доп. II Міжнар. конф. – Донецьк, 1994. – С. 138.

32. Сопротивление двухслойной полупроводниковой структуры в процессе инъекции зарядов через точечный контакт / Н. Н. Голоденко, Ю. Н. Гриценко, В. А. Надточий, Н. К. Нечволод; Славянский гос. пед. ин-т. – Славянск, 1994. – 23 с. – Деп. в ГНТБ Украины 15.08.94, № 1694. – Ук. 94.

### 1995

33. Голографія і принцип Гюйгенса – Френеля / В. О. Надточий, М. М. Голоденко, М. К. Нечволод // Шляхи удосконалення фундаментальної і професійної підготовки вчителів фізики : тези доп. II Всеукр. конф., 24–25 трав. 1995 р. / Київ. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1995. – Ч. 1. – С. 54.

34. Зміст освіти і можливості НІТ / В. О. Надточій, Л. С. Шуригіна // Шляхи удосконалення фундаментальної і професійної підготовки вчителів фізики : тези доп. II Всеукр. конф., 24–25 трав. 1995 р. / Київ. держ. пед. ун-т. ім. М. П. Драгоманова. – К., 1995. – Ч. 1. – С. 11.

35. Система підготовки майбутнього вчителя фізики / В. О. Надточій, В. Н. Рибенцев // Шляхи удосконалення фундаментальної і професійної підготовки вчителів фізики : тези доп. II Всеукр. конф., 24–25 травня 1995 р. / Київ. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1995. – Ч. 1. – С. 16.

36. Шляхи гуманітаризації викладання фізики / В. О. Надточій, Л. С. Шуригіна, М. М. Голоденко // Шляхи удосконалення фундаментальної і професійної підготовки вчителів фізики : тези доп. II Всеукр. конф., 24–25 трав. 1995 р. / Київ. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1995. – Ч. 1. – С. 10.

37. Время жизни носителей в дефектном поверхностном слое полупроводника / В. А. Надточий, Н. Н. Голоденко, Ю. Н. Гриценко, Н. К. Нечволод; Славянский гос. пед. ин-т. – Славянск, 1995. – 23 с. – Деп. в ГНТБ Украины 01.06.95, № 1344. – Ук. 95.

### 1996

38. Дефектный поверхностный слой, возникающий в монокристаллическом Ge при низкотемпературной деформации / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, Н. Н. Голоденко, Ю. Н. Гриценко, О. Н. Панютин // Вакуумная металлизация : сб. науч. тр. – Х., 1996. – Т. 2. – С. 77–81.

39. Про вдосконалення змісту шкільної фізичної освіти / В. О. Надточій, Л. С. Шуригіна // Методичні особливості викладання фізики на сучасному етапі : матеріали доп. II Міжвуз. наук.-практ. конф. – Кіровоград, 1996. – Ч. 1. – С. 92–93.

40. Pneumatik pendulum // V. Nadtochiy, N. Golodenko, L. Shyrygina, Y. Gritsenko // Методологические, дидактические и психологические аспекты проблемного обучения : материалы IV Междунар. науч.-метод. конф. – Донецк, 1996. – С. 32.

41. Исследование сферического p-n-перехода методом модуляции проводимости / В. А. Надточий, Н. Н. Голоденко, Ю. Н. Гриценко, Н. К. Нечволод; Славянский гос. пед. ин-т. – Слов'янськ, 1996. – Деп. в ГНТБ Украины 24.10.96, № 2049. – Ук 96.

### 1997

42. Использование аналогий для создания проблемных ситуаций / В. А. Надточий, Л. С. Шурыгина // Современные проблемы дидактики высшей школы : тез. докл. Междунар. конф., 27–31 авг. 1997 г. – Донецк, 1997.

43. Фізика як засіб гуманітаризації освітньо-професійної підготовки вчителя технологій / М. К. Нечволод, Л. С. Шуригіна, В. О. Надточій, // Проблеми трудової і професійної підготовки : наук.-метод. зб. – К.; Слов'янськ, 1997. – Вип. 1. – С. 51–53.

44. Фізика як засіб гуманітаризації освітньо-професійної підготовки вчителя технологій / М. К. Нечволод, Л. С. Шуригіна, В. О. Надточій // Трудова підготовка школярів та підготовка вчителів трудового навчання: історія, сучасність, перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф., 2–3 жовт. 1997 р. – К.; Слов'янськ, 1997. – С. 62–65.

### 1998

45. До методики вивчення електричних машин / В. О. Надточій, Л. С. Шуригіна, М. К. Нечволод, М. М. Голоденко // Методичні особливості викладання фізики на сучасному етапі : зб. наук. праць. – Кіровоград, 1998. – Ч. 2. – С. 116–117.
46. Комп'ютерне моделювання в навчальному процесі / В. О. Надточій, М. М. Голоденко, Ю. М. Гриценко, Н. К. Нечволод, // Методичні особливості викладання фізики на сучасному етапі : зб. наук. праць. – Кіровоград, 1998. – Ч. 2. – С. 143–144.
47. Про формування наукового світогляду в сучасних умовах у студентів фізико-математичного факультету при вивченні фізики / В. О. Надточій, В. Н. Рибенцев // Методичні особливості викладання фізики на сучасному етапі : зб. наук. праць. – Кіровоград, 1998. – Ч. 2. – С. 14.
48. З досвіду викладання фізики в ліцеї / В. О. Надточій, О. Я. Белошапка, В. Н. Рибенцев // Наука і освіта - 98 : тези I Міжнар. конф., 28–30 квіт. 1998 р. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 110.
49. Фізика як засіб гуманітаризації освітньо-професійної підготовки вчителя технологій / М. К. Нечволод, Л. С. Шуригіна, В. О. Надточій // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К., 1998. – Вип. 11. – С. 52–55.
50. Логарифмическая ползучесть поликристаллической меди / В. А. Надточий, Н. Н. Голоденко, Ю. Н. Гриценко, Н. К. Нечволод // Придніпровський науковий вісник. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 114.
51. Логарифмическая ползучесть при ступенчатом нагружении / Н. Н. Голоденко, Ю. Н. Гриценко, В. А. Надточий, Н. К. Нечволод; Славянский гос. пед. ин-т. – Славянск, 1998. – 29 с. – Деп. в ГНТБ Украины 23.03.98, № 158. – Ук. 98.

### 1999

52. Визначення коефіцієнту тертя кочення / В. О. Надточій, Л. С. Шуригіна, М. К. Нечволод, М. М. Голоденко // Наук.-метод. зб. з проблем навчального фізичного експерименту. – Чернігів, 1999. – С. 22.
53. Комп'ютерне моделювання досліду Франка-Герца / Л. С. Шуригіна, М. М. Голоденко, В. О. Надточій, В. М. Ткаченко // Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в освітній діяльності : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 1999. – С. 12–15.
54. Электрические свойства кремниевых р-n-переходов с дислокациями, созданными низкотемпературной деформацией / В. О. Надточий, Н. К. Нечволод, Н. Н. Голоденко, Д. Г. Сущенко // Алмазные пленки и пленки родственных материалов : сб. докл. 4-го Междунар. симпозиума по алмазным пленкам и родственными материалам. – Х., 1999. – С. 327–330.
55. Математическое моделирование низкотемпературной пластической деформации / Н. Н. Голоденко, Ю. Н. Гриценко, В. О. Надточий, Н. К. Нечволод; Славянский гос. пед. ин-т. – Славянск, 1999. – 24 с. – Деп. в ГНТБ Украины 11.05.99, № 126. – Ук. 99.

## 2000

56. Дослідження напівпровідників методом вимірювання вольт-фарадних характеристик / В. О. Надточій, В. М. Ткаченко, О. П. Каменів // Фундаментальна та професійна підготовка фахівця з фізики : матеріали V Всеукр. наук. конф., 6–7 черв. 2000 р. – К., 2000.

57. Емоційний фактор у викладанні фізики / В. О. Надточій, Л. С. Шуригіна, М. К. Нечволод, М. М. Голоденко // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : зб.наук. тез. (За підсумками роботи Міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2000.

58. Измерение времени жизни носителей заряда и толщины дефектного поверхностного слоя полупроводника методом модуляции проводимости в точечном контакте / В. А. Надточий, Н. Н. Голоденко, Н. К. Нечволод, Д. Г. Сущенко // Вестник Донецкого гос. ун-та. Сер. А, Природничі науки. – 2000. – № 1. – С. 98–103.

59. Исследование электрических свойств полупроводников со структурой алмаза и сфалерита, деформированных при низких температурах / В. А. Надточий, М. К. Нечволод // Высокие давления – 2000 : тез. докл. Междунар. конф. / Донецкий физ.-тех. ин-т им. А. А. Галкина. – Донецк, 2000.

60. Наукова робота студентів як елемент навчального процесу / В. О. Надточій, М. М. Голоденко, Ю. М. Гриценко, Я. Г. Беличенко, О. В. Періг // Фундаментальна та професійна підготовка фахівця з фізики : матеріали V Всеукр. наук. конф., 6–7 черв. 2000 р. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2000.

61. До теорії логарифмічної низькотемпературної повзучості, зумовленої виснаженням дислокацій / М. К. Нечволод, М. М. Голоденко, В. О. Надточій, Ю. М. Гриценко, Д. Г. Сущенко // Журнал фізичних досліджень. – 2000. – Т. 4. – № 3. – С. 298–302.

62. Действие абразивных частиц на поверхность полупроводника в процессе химико-механического полирования / А. А. Белошапка, А. Я. Белошапка, Н. Н. Голоденко, Ю. Н. Гриценко, В. А. Надточий, Н. К. Нечволод; Славянский гос. пед. ин-т. – Славянск, 2000. – 9 с. : ил. – Деп. в ГНТБ Украины 27.04.2000, № 96 – Ук. 2000.

## 2001

63. Компьютерное моделирование опытов Франка-Герца / В. А. Надточий, А. М. Берестовой, А. Г. Лебедь, Н. Н. Голоденко, Н. К. Нечволод // Актуальные проблемы инженерной подготовки специалистов в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля : науч. сб. – Х., 2001. – С. 214.

64. Комп'ютерне тестування як елемент процесу навчання / В. О. Надточій, М. М. Голоденко, А. Ф. Прун, Ю. М. Гриценко // Інформаційні технології в освіті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16–19 трав. 2001 р. / Мелітопольський держ. пед. ун-т. – Мелітополь, 2001.

65. Проблемы современных образовательных технологий / Н. К. Нечволод, А. М. Берестовой, Н. Н. Голоденко, В. А. Надточий, Л. С. Шуригіна //



Управление качеством профессионального образования : междунар. науч.-метод. конф. (Артемовск, 24–27 апр. 2001 г.) : сб. науч. тр. – Донецк, 2001. – С. 265–268.

66. Исследование электрических свойств Ge и Si, деформированных при низких температурах / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, Д. Г. Сущенко // Физика и техника высоких давлений. – 2001. – Т. 11. – № 1. – С. 104–110.

67. Про рекомбінацію нерівноважних носіїв заряду у дефектному поверхневому шарі монокристалічного Ge / В. О. Надточій, М. К. Нечволод, М. М. Голоденко, Д. Г. Сущенко // Фізика і хімія твердого тіла. – 2001. – Т. 2. – № 4. – С. 707–710.

## 2002

68. Генерация дислокаций на включениях в приповерхностных слоях деформируемых полупроводниковых кристаллов / Я. Г. Беличенко, В. А. Надточий, Н. Н. Голоденко // Політ-2002. Наука і молодь : матеріали міжнар. наук. конф. студ. та молодих учених, 10–11 квітня 2002 р. / Нац. авіаційний ун-т. – К., 2002. – С. 202.

69. Движение дислокаций в приповерхностных слоях полупроводниковых кристаллов, подвергаемых механическим деформациям / В. А. Надточий, А. В. Периг, Н. Н. Голоденко // Політ-2002. Наука і молодь : матеріали міжнар. наук. конф. студ. та молодих учених, 10–11 квітня 2002 р. / Нац. авіаційний ун-т. – К., 2002. – С. 203.

70. Генерация дислокаций на сферических включениях в кристаллах под действием одноосного напряжения сжатия / И. В. Жихарев, В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, Н. Н. Голоденко, Я. Г. Беличенко // Вісник Донецького ун-ту. Сер. А, Природничі науки. – 2002. – № 2. – С. 197–200.

71. Исследование микропластичности полупроводника InAs / В. А. Надточий, А. С. Савченко // Пошуки і знахідки : матеріали наук. конф. СДП. – Слов'янськ, 2002. – С. 77–79.

72. Микропластичность и электрические свойства алмазоподобных полупроводников, деформированных при низких температурах / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, Н. Н. Голоденко // I Українська наук. конф. з фізики напівпровідників УНКФН-1 (з міжнародною участю) 10–14 верес. 2002 р. : тези доп. – Одеса, 2002. – Вип. 2. – С. 70.

## 2003

73. Дислокационная структура приповерхностных слоев Ge, обусловленная воздействием лазерного луча миллисекундной длительности / В. А. Надточий, Н. Н. Голоденко, А. З. Калимбет Д. С. Москаль // Актуальні проблеми фізики напівпровідників : тези доп. IV Міжнар школи-конф., 24–27 черв. 2003 р. – Дрогобич, 2003. – С. 43–44.

74. Исследование дислокаций сканирующим электронным пучком / В. А. Надточий, Н. Н. Голоденко, Д. С. Москаль // Сучасні питання матеріалознавства : зб. наук. праць відкритої Всеукр. конф., 10–14 верес. 2003 р. – Х., 2003. – С. 95.

75. Микропластичность и электрические свойства Ge и Si, деформированных при низких температурах / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, Н. Н. Голоденко // Вісник Харківського Нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер.600, Фізика. – 2003. – Вип. 7. – С. 101–108.

76. Микропластичность приповерхностных слоев алмазоподобных полупроводников / В. П. Алехин, В. А. Надточий // XIV Петербургские чтения по проблемам прочности, посвящ. 300-летию Санкт-Петербурга, 12–14 марта 2003 г. : сб. тез. – СПб., 2003. – С. 42–43.

77. Низкотемпературная микропластичность кристаллов InAs / В. А. Надточий, Н. Н. Голоденко, Д. С. Москаль, А. З. Калимбет // Міжнарод. наук. конф. студентів та молодих учених. : тези доп. / Нац. авіаційний ун-т. – К., 2003. – С. 19.

78. Про фізичний механізм виникнення дислокацій у приповерхневих шарах Ge під дією лазерного опромінювання мілісекундної тривалості / В. О. Надточій, М. М. Голоденко, Д. С. Москаль // Еврика-2003 : тези доп. Всеукр. конф. студентів. і молодих науковців з теорет. та експерим. фізики, 21–23 травня : тези доп. – Львів, 2003. – С. 136.

79. Formation of Defect in Ge Subsurface Layers under the Action of Laser Pulse / В. О. Надточій, М. М. Голоденко, Д. С. Москаль // Фізика і технологія тонких плівок : тези матеріалів ІХ Міжнарод. конф. МКФТТІ-ІХ., 19–24 трав. 2003 р. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 247–248.

80. Structure changes caused by the stress gradient in subsurface layers of germanium single crystals [Електронний ресурс] / V. Nadtochiy, I. Zhikharev, M. Golodenko, M. Nechvolod // Interfacial effects and novel properties of nanomaterials : fall meeting. symposium C., Warsaw, 14–18 september 2002. – Режим доступу : Thesis of [www.scientific.net](http://www.scientific.net).

81. Рентгеновские исследования дефектов структуры в приповерхностных слоях монокристаллов германия и кремния, деформированных при 310 К / В. А. Надточий, И. В. Жихарев, Н. Н. Голоденко, Н. С. Киселев // Физика и техника высоких давлений. – 2003. – Т. 13. – № 1. – С. 91–95.

82. Рух дислокацій у напівпровідниках, спричинений градієнтом напружень / В. О. Надточій, М. М. Голоденко, М. К. Нечволод, І. В. Жихарев, О. В. Періг // Фізика і хімія твердого тіла. – 2003. – Т. 4. – № 1. – С. 76–79.

83. Структурні зміни у приповерхневому шарі Ge під дією лазерного імпульсу / В. О. Надточій, М. М. Голоденко, А. З. Калимбет, Д. С. Москаль // Фізика і хімія твердого тіла. – 2003. – Т. 4. – № 3. – С. 556–559.

84. Структурные изменения в зоне действия лазерного луча в монокристаллическом германии / В. А. Надточий, В. П. Алехин, Н. Н. Голоденко, М. К. Нечволод, Д. С. Москаль // Физика и химия обработки материалов. – 2003. – № 4. – С. 9–12.

85. Microplasticity and Electrical Properties of Subsurface Layers of Diamond-like Semiconductors Deformed at Low Temperatures / V. Nadtochiy, M. Nechvolod, N. Golodenko // Functional Materials. – 2003. – Vol. 10. – № 4. – P. 702–706.

86. Structure Changes Caused by the Stress Gradient in Subsurface Layers of Germanium Single Crystals / V. Nadtochiy, I. Zhikharev, N. Golodenko, N. Nechvolod // *Solid State Phenomena*. – 2003. – Vol. 94. – P. 253–257.

## 2004

87. Изменение времени жизни носителей заряда и проводимости дефектного приповерхностного слоя Ge при термообработках / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, Н. Н. Голоденко // *Физика и техника высоких давлений*. – 2004. – Т. 14. – № 3. – С. 42–48.

88. Микропластичность монокристаллов Ge при воздействии лазерного облучения и деформации сжатия / В. А. Надточий, В. П. Алехин // *Физика и химия обработки материалов*. – 2004. – № 4. – С. 27–32.

89. Структурные изменения в кристаллах GaAs, деформированных сжатием при 300 К / Д. С. Москаль, В. А. Надточий, Н. Н. Голоденко // *Сенсорна електроніка і мікросхемні технології*. – 2004. – № 2. – С. 89–93.

90. Установка для исследования микропластичности полупроводниковых кристаллов / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, Д. С. Москаль // *Физика и техника высоких давлений*. – 2004. – Т. 14. – № 2. – С. 117–121.

91. Investigation of Dislocation in Ge single crystals by scanning Electron beam / V. Nadtochiy, M. Golodenko, D. Moskal // *Functional Materials*. – 2004. – Vol. 11. – № 1. – P. 40–43.

## 2005

92. Дислокації у приповерхневому шарі Ge, причинені лазерним імпульсом / В. О. Надточий, М. К. Нечволод, М. М. Голоденко, Д. С. Москаль // *Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Фізика*. – Х., 2005. – Т. 651. – Вип. 8. – С. 130–135.

93. Дія абразивних часток на поверхню монокристала у процесі хіміко-механічного полірування / В. О. Надточий, М. М. Голоденко, О. Я. Белошапка // *Вісник Слов'янського держ. пед.ун-ту : зб. наук. праць*. – Слов'янськ, 2005. – Вип. 1. – С. 32–38.

94. Микропластичність у кристалах GaAs / В. О. Надточій, М. М. Голоденко // *Актуальні проблеми фізики напівпровідників : тези доп. V Міжнар. школи-конф., 27–30 черв. 2005 р. – Дрогобич, 2005*. – С. 10–11.

95. Про фізичний механізм виникнення дислокацій у приповерхневих шарах Ge під дією лазерного опромінювання мілісекундної тривалості / В. О. Надточий, М. М. Голоденко, Д. С. Москаль // *Вісник Львівського ун-ту. Серія фізична*. – 2005. – № 38 (1). – С. 183–190.

96. Розрахунок термопружних полів у кристалах GaAs, спричинених дією лазерного променя з дифракційною просторовою модуляцією / В. О. Надточій, Д. С. Москаль, М. М. Голоденко // *Наука і молодь : зб. наук. праць міжнар. наук. конф. "Політ-2005" / Нац. авіаційний ін-т*. – К., 2005. – Вип. 5. – С. 23–25.

97. Розрахунок термопружних полів у кристалах GaAs, спричинених дією лазерного променя з дифракційною просторовою модуляцією / В. О. Надточій, Д. С. Москаль, М. М. Голоденко // Політ-2005 : тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12–13 квіт. 2005 р. / Нац. авіаційний ін-т. – К., 2005. – С. 94.

98. Утворення періодичних структур у приповерхневих шарах GaAs під дією імпульсного лазерного опромінення / В. О. Надточій, М. М. Голоденко, Д. С. Москаль // Вісник Слов'янського пед. ун-ту : зб. наук. праць. – Слов'янськ, 2005. – Вип. 1. – С. 27–31.

99. Анизотропия микропластичности германия / В. А. Надточий, В. П. Алехин, Н. С. Киселев // Физика и химия обработки материалов. – 2005. – № 1. – С. 90-93.

100. Microplasticity of subsurface layers of diamond-like semiconductors under microindentation / V.A. Nadtochiy, V. P. Alyokhin, M. M. Golodenko // Физика и техника высоких давлений. – 2005. – Т 15. – № 1. – С. 44–49.

101. Formation of periodic structures in GaAs near-surface layers irradiated by laser pulse / D. Moskal, V. Nadtochiy, N. Golodenko // Photoelectronics. – 2005. – Vol. 14. – P. 105–107.

102. Recombination of non-equilibrium charge carriers injected into Ge through intermediate defective layer / V. Nadtochiy, N. Nechvolod, N. Golodenko // Functional Materials – 2005. – Vol. 12. – № 1. – P. 45–50.

## 2006

103. Анализ рельефа поверхности GaAs, сформированного под воздействием дифракционно-модулированного лазерного излучения / Д. С. Москаль, В. А. Надточий, Н. Н. Голоденко // Актуальные проблемы прочности : сб. тез. 45-й Междунар. конф., 25–28 сент. 2006 г. / Белгород. гос. ун-т. – Белгород, 2006. – С. 117–118.

104. Periodic structure formation in GaAs near – surface layer by laser beam with diffraction modulated intensity / V. Nadtochiy, D. Moskal, N. Golodenko // Functional Materials. – 2006. – Vol. 13. – № 1. – P. 100–103.

105. Мікропластичність алмазоподібних кристалів (Si, Ge, GaAs, InAs) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Надточій Віктор Олексійович. – Х., 2006. – 36 с.

## 2007

106. Мікропластичність алмазоподібних кристалів / В. О. Надточій, М. К. Нечволод, Д. С. Москаль // XI Міжнар. конф. з фізики і технології тонких плівок та наносистем, 7–12 трав. 2007 р. : тези доп. – Івано-Франківськ, 2007. – Т. 2. – С. 122–123.

107. О механизме упрочнения приповерхностного слоя германия под действием низкотемпературной циклической деформации / В. А. Надточий, Н. К. Нечволод, Д. С. Москаль // XVII Петербургские чтения по проблемам прочности, посвящ. 90-летию со дня рождения проф. А. Н. Орлова, 10–12 апр. 2007 г. : сб. материалов. – СПб., 2007. – Ч. II. – С. 126–127.

108. Анализ рельефа поверхности GaAs, сформированного воздействием дифракционно-модулированного лазерного излучения / Д. С. Москаль, В. А. Надточий, Н. Н. Голоденко // Известия высших учебных заведений. Физика. – Томск, 2007. – Т. 50. – № 11. – С. 86–89.

109. Analysis the relief of the GaAs surface formed upon exposure to diffraction-modulated laser radiation / D. Moskal, V. Nadtochiy, N. Golodenko // Russian Physics Journal. – 2007. – Vol. 50. – No 11. – P. 1154–1157.

### 2008

110. Електротехніка : методичні вказівки по організації і плануванню самостійної роботи студентів спеціальності 6.040203 "Фізика" / В. О. Надточій, А. Ф. Прун; Слов'янський держ. пед. ун-т. – Слов'янськ : [б. в.], 2008. – 86 с.

111. Дифузійний механізм формування кластерів у GaAs під дією просторово-періодичного лазерного опромінення / Д. С. Москаль, В. О. Надточій, Л. Л. Федоренко, М. М. Юсупов // Лашкар'євські читання–2008 : тези доп. конф. молодих вчених з фізики напівпровідників, 21–23 квіт. 2008 р. – К., 2008. – С. 40–41.

112. Дифузійно-дислокаційна модель утворення періодичної структури на поверхні напівпровідника при імпульсному лазерному опроміненні / В. О. Надточій, М. К. Нечволод, Д. С. Москаль // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології (СЕМСТ-3) : тези доп. 3-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 2–6 черв. 2008 р. – Одеса, 2008. – С. 185.

113. Распределение термоупругих напряжений по облучаемой лазерным импульсом поверхности монокристаллов GaAs / Д. С. Москаль, В. А. Надточий // Физика и техника высоких давлений. – 2008. – Т. 18. – № 3. – С. 154–160.

### 2009

114. Дифузійно-дислокаційна мікропластичність монокристаллів Ge нижче температурної межі крихкого руйнування / О. І. Уколов, В. О. Надточій // Еврика-2009 : тези доп. Міжнар. конф. студ. і молодих науковців з теорет. та експерим. фізики, 20–22 трав. 2009 р. – Львів, 2009. – С. 34.

115. Комп'ютерне синтезування дифракційних масок / Д. С. Москаль, В. О. Надточій, А. З. Калімбет // Пошуки і знахідки : матеріали наук. конф. Слов'янського держ. пед. ун-ту (квіт. 2009 р.) / уклад. В. К. Сарієнко. – Слов'янськ, 2009. – С. 131–134.

### 2010

116. Измерения времени жизни неосновных носителей заряда в приповерхностном слое с дефектами монокристалла германия / А. И. Уколов, В. А. Надточий, Н. К. Нечволод // Лашкар'євські читання-2010 : зб. тез конф. молодих вчених з фізики напівпровідників, 5–7 жовт. 2010 р. – К., 2010. – С. 49–50.

117. Некоторые механизмы разрушения ковалентных кристаллов при пониженных температурах / А. И. Уколов, В. А. Надточий // Актуальные проблемы прочности : тез. докл. 49-ой Междунар. конф., 14–18 июня 2010 г. – К., 2010. – С. 232.

118. О применимости методик определения параметров рекомбинации носителей заряда к приповерхностным слоям полупроводника / А. И. Уколов, В. А. Надточий, А. З. Калимбет, Д. С. Москаль // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки : зб. наук. праць за матеріалами наук. конф. Слов'янського держ. пед. ун-ту, 20–22 квіт. 2010 р. – Слов'янськ, 2010. – С. 88–94.

119. О роли диффузионных механизмов в процессе релаксации напряжений на концентраторах в монокристаллическом германии / В. А. Надточий, А. И. Уколов, Н. К. Нечволод // XIX Петербургские чтения по проблемам прочности, посвящ. 130-летию со дня рождения акад. АН УССР Н. Н. Давиденкова, 13–15 апр. 2010 г. : сб. материалов. – СПб., 2010. – Ч. 2. – С. 298–300.

120. Дифузійно-дислокаційна мікропластичність монокристалів Ge нижче температурної межі крихкого руйнування / О. І. Уколов, В. О. Надточій, М. К. Нечволод // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т. 11. – № 3. – С. 575–579.

## 2011

121. Визначення швидкості поверхневої рекомбінації і її впливу на час життя нерівноважних носіїв заряду / О. І. Уколов, В. О. Надточій, А. З. Калимбет // Збірник наук. праць фізико-мат. фак-ту СДПУ : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. "Актуальні питання науки і освіти", 19–21 квіт. 2011 р. – Слов'янськ, 2011. – Вип. 1. – С. 83–87.

122. Влияние различных термических изменений на логарифмическую ползучесть монокристаллов фтористого лития (LiF) в области действия физического механизма истощения дислокаций / Н. К. Нечволод, И. В. Малеев, В. А. Надточий, А. И. Уколов, А. З. Калимбет // Вісник Донбаської держ. машинобудів. акад. : зб. наук. праць. – Краматорськ, 2011. – № 4. – С. 127–132.

123. Измерения времени жизни неосновных носителей заряда в приповерхностном слое монокристаллического Ge зондовым методом / А. И. Уколов, В. А. Надточий, Н. Н. Голоденко // Вісник Харківського нац. ун-ту. Серія. 962, Фізика. – Х., 2011. – Вип. 15. – С. 63–66.

124. Измерение параметров рекомбинации неравновесных носителей зарядов в приповерхностных слоях монокристалла германия / А. И. Уколов, В. А. Надточий, Ю. В. Уколова // Лашкарьовські читання–2011 : зб. тез конф. молодих вчених з фізики напівпровідників, 12–14 трав. 2011 р. – К., 2011. – С. 8–10.

125. Получение низкоразмерных структур на поверхности монокристаллического германия низкотемпературным деформированием / В. А. Надточий, А. И. Уколов // Фізичні явища в твердих тілах : матеріали X Міжнар. наук. конф., 3–8 груд. 2011 р. / Харківський нац. ун-т. – Х., 2011. – С. 2.

## 2012

126. Вплив різних термічних змін на логарифмічну повзучість монокристалів LiF в області дії фізичного механізму виснаження дислокацій / М. К. Нечволод, І. В. Малєєв, В. О. Надточій, О. І. Уколов, А. З. Калімбет // Збірник наук. праць фізико-математичного факультету СДПУ [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. "Актуальні питання сучасної науки і освіти", 24–26 квіт. 2012 р.]. – Слов'янськ, 2012. – Вип. 2. – С 100–108.

127. Измерение параметров рекомбинации неравновесных носителей заряда в приповерхностных слоях монокристаллического Ge / В. А. Надточий, А. И. Уколов, О. К. Попов, С. А. Перебайло // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. "Актуальні питання сучасної науки і освіти", 24–26 квіт. 2012 р.] – Слов'янськ, 2012. – Вип. 2. – С. 87–93.

128. Исследование наноструктур на поверхности монокристаллического Ge методом атомно-силовой микроскопии / В. А. Надточий, А. И. Уколов, С. А. Костенко, Д. Ю. Редников // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. "Актуальні питання сучасної науки і освіти", 24–26 квіт. 2012 р.]. – Слов'янськ, 2012. – Вип. 2. – С. 94–99.

129. Образование наноструктур на поверхности германия при деформировании в температурном интервале (300-600) К / В. А. Надточий, А. И. Уколов, Н. К. Нечволод // XX Петербургские чтения по проблемам прочности, посвящ. памяти проф. В. А. Лихачева, 10–12 апр. 2012 г. : тез. докл. – СПб., 2012. – С. 228–230.

130. Устройство для измерения параметров рекомбинации неравновесных носителей заряда в приповерхностных слоях монокристаллов Ge / В. А. Надточий, А. И. Уколов // Вісник Харківського нац. ун-ту. Серія: фізика. – Х., 2012. – № 1020. – Вип. 17. – С. 87–90.

131. Исследование поверхности деформированного Ge методом атомно-силовой микроскопии / В. А. Надточий, А. И. Уколов, В. П. Алехин // Деформация и разрушение материалов. – М., 2012. – № 4. – С. 26–32.

132. Формирование наноструктур в Ge при условии дислокационно-поверхностной диффузии / В. А. Надточий, А. И. Уколов, Н. К. Нечволод // Физика и техника высоких давлений. – 2012. – Т. 22. – № 3. – С. 54–62.

133. Пат. 97999 Україна (19) UA (11) 97999 (13) C2 (51) МПК G01N 27/87 (2006.01) Спосіб визначення міри дефектності приповерхневих шарів монокристалів германію або кремнію / В. А. Надточій, О. І. Уколов; заявник і патентоудержувач Слов'янський держ. пед. ун-т. – № 201003112; заяв. 18.03.00 ; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7.

### 2013

134. Исследование распределения дефектов в полупроводниковых пластинах интегральных схем при воздействии механических напряжений / В. А. Надточий, А. И. Уколов, И. Л. Щербина, Р. И. Иванов // Збірник наукових праць фізико-математичного фак-ту ДДПУ [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. "Актуальні питання сучасної науки і освіти", 23–25 квіт. 2013 р.]. – Слов'янськ, 2013. – Вип. 3. – С. 77–85.

135. Формування наноструктур у монокристалічному германії за умови дислокаційно-поверхневої дифузії / В. А. Надточій, О. І. Уколов, І. О. Хорунжа, М. А. Полтавцев // Збірник наукових праць фізико-математичного фак-ту ДДПУ. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. "Актуальні питання сучасної науки і освіти", 23–25 квіт. 2013 р.] – Слов'янськ, 2013. – Вип. 3. – С. 68–76.

136. Стимулированная напряжением поверхностная диффузия и ее влияние на разрушение монокристаллов Ge / В. А. Надточий, А. И. Уколов // Фізичні явища в твердих тілах : матеріали XI Міжнар. наук. конф., 3–6 груд. 2013 р. / Харківський нац. ун-т. ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2013. – С. 108.

137. Формирование массивов наноструктур на поверхности германия при создании градиента напряжения / А. И. Уколов, В. А. Надточий, Н. К. Нечволод // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технич. науки. – 2013. – Т. 18. – Вип. 4. – С. 2004–2005.

138. Распределение дефектов в тонких полупроводниковых пластинах при низкотемпературной деформации / А. И. Уколов, В. А. Надточий, Н. К. Нечволод // Физика и техника высоких давлений. – 2013. – Т. 23. – № 4. – С.83–91.

139. Пат. 101705 Україна (19) UA (11) C2 (51) VGR H01L 27/322 (2006.01). Спосіб створення наноструктур на поверхні германію / В. О. Надточій, О. І. Уколов; заявник і патентоудержувач Слов'янський держ. пед. ун-т. – № 201108095; заявл. 29.06.11 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8.

### 2014

140. Измерение диффузионной длины носителей заряда в приповерхностных слоях монокристалла германия / А. И. Уколов, В. А. Надточий, Д. В. Сыроев // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. "Актуальні питання сучасної науки і освіти", 22–24 квіт. 2014 р.]. – Слов'янськ, 2014. – Вип. 4. – С. 91–96.

141. Свойства наноструктур, сформированных на поверхности Ge диффузионным массопереносом / А. И. Уколов, В. А. Надточий, А. С. Винокурова, А. З. Калимбет // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. "Актуальні питання сучасної науки і освіти", 22–24 квіт. 2014 р.]. – Слов'янськ, 2014. – Вип. 4. – С. 85–91.



## Розділ II. Наукова школа вченого В. О. Надточія

Дисертації та автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук

### 2008

142. Москаль Д. С. Дефектоутворення у приповерхневих шарах монокристалів GaAs під впливом низькорівневого просторово-модульованого лазерного опромінення : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Москаль Денис Степанович; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2008. – 162 с.
143. Москаль Д. С. Дефектоутворення у приповерхневих шарах монокристалів GaAs під впливом низькорівневого просторово-модульованого лазерного опромінення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Д. С. Москаль; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2008. – 19 с.

### 2014

144. Уколов О. І. Утворення дефектів і низько-розмірних атомних структур у приповерхневих шарах германію під час деформації в інтервалі температур 300-600 К : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Уколов Олексій Іванович; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2014. – 163 с.
145. Уколов О. І. Утворення дефектів і низько-розмірних атомних структур у приповерхневих шарах германію під час деформації в інтервалі температур 300-600 К : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / О. І. Уколов; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2014. – 20 с.

### **Розділ III. Література про життя та діяльність**

146. До 75-річчя Надточія Віктора Олексійовича / М. К. Нечволод, А. З. Калімбет, Л. С. Шуригіна [та ін.] // Збірник наукових праць фіз.-мат. фак-ту ДДПУ [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. "Актуальні питання сучасної науки і освіти", 22–24 квіт. 2014 р.]. – Слов'янськ, 2014. – С. 4–16.
147. Нечволод М. К. Від педагогічного училища до державного педагогічного університету / М. К. Нечволод // Славянская правда. – 2014. – 9 янв. (№2). – С. 18.

## Допоміжні покажчики

### Іменний покажчик

- Алехин В. П. ( Alyokhin V.) 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 76, 84, 88, 99, 100, 131
- Беличенко Я. Г. 60, 68, 70  
 Белошапка А. А. 62  
 Белошапка А. Я. 19, 48, 62, 93  
 Берестовой А. М. 63, 65
- Вареца В. П. 16  
 Винокурова А. С. 141
- Голоденко Н. Н. (Golodenko N.) 25, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 123  
 Господаревский В. В. 17  
 Гриценко Ю. М. (Gritsenko Y.) 27, 29, 31, 32, 37, 38, 40, 41, 46, 50, 51, 55, 60, 61, 62, 64
- Жихарев И. В. (Zhikharev I.) 70, 80, 81, 82, 86
- Золотухин В. А. 21
- Иванов Р. И. 134
- Каменев О. П. 56  
 Калимбет А. З. (Калімбет) 16, 18, 19, 73, 77, 83, 115, 118, 121, 122, 126, 141, 146.  
 Киселев Н. С. 81, 99  
 Костенко С. А. 128
- Лебедь А. Г. 63
- Малеев И. В. (Малеев) 122, 126  
 Москаль Д. С. ( Moskal D.) 73, 74, 77, 78, 79, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 118, 142, 143.

Нечволод Н. К. (М. К.) (Nechvolod M) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 27, 28, 29, 32, 33, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 72, 75, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 102, 106, 107, 112, 116, 119, 120, 122, 126, 129, 132, 137, 138, 146, 147

Олейник Р. В. 20

Панютин О. Н. 38

Перебайло С. А. 127

Периг А. В. (Періг) 60, 69, 82

Полтавцев М. А. 135

Попов О. К. 127

Прун А. Ф. 64, 110

Редникин Д. Ю. 128

Рыбенцев В. Н. (Рибенцев) 23, 35, 47, 48

Савченко А. С. 71

Сарієнко В. Н. 115

Свиридюк Б. А. 25

Сущенко Д. Г. 54, 58, 61, 66, 67

Сысоев Д. В. 140

Тихонов А. П. 5, 8, 9

Ткаченко В. Н. (В. М.) 26, 53, 56

Уколов О. І. (А. И.) 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 145

Уколова Ю. В. 124

Федоренко Л. Л. 111

Хорунжа І. О. 135

Шоршоров М. Х. 3, 4, 7, 8, 11, 15, 16, 17

Шурыгина Л. С. (Шуригіна) (Shuryigina L.) 22, 24, 26, 30, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 52, 53, 57, 65, 146

Щербина И. Л. 134

Юсупов М. М. 111

## Алфавітний покажчик праць В. О. Надточія

- Автоматизированная установка на базе микро-ЭВМ для определения концентрации примесей в полупроводниках 26
- Анализ рельефа поверхности GaAs, сформированного воздействием дифракционно-модулированного лазерного излучения 108
- Анализ рельефа поверхности GaAs, сформированного под воздействием дифракционно-модулированного лазерного излучения 103
- Анизотропия микропластичности германия 99
- Важный результат повышения качества профессиональной подготовки выпускника педвуза 20
- Визначення коефіцієнту тертя кочення 52
- Визначення швидкості поверхневої рекомбінації і її впливу на час життя нерівноважних носіїв заряду 121
- Влияние низкотемпературной микропластической деформации на электрические свойства кремниевых p-n переходов 19
- Влияние различных термических изменений на логарифмическую ползучесть монокристаллов фтористого лития (LiF) в области действия физического механизма истощения дислокаций 122
- Вплив різних термічних змін на логарифмічну повзучість монокристалів LiF в області дії фізичного механізму виснаження дислокацій 126
- Время жизни носителей в дефектном поверхностном слое полупроводника 37
- Генерация дислокаций на включениях в приповерхностных слоях деформируемых полупроводниковых кристаллов 68
- Генерация дислокаций на сферических включениях в кристаллах под действием одноосного напряжения сжатия 70
- Голографія і принцип Гюйгенса – Френеля 33
- Движение дислокаций в приповерхностных слоях полупроводниковых кристаллов, подвергаемых механическим деформациям 69
- Действие абразивных частиц на поверхность полупроводника в процессе химико-механического полирования 62
- Дефектный поверхностный слой, возникающий в монокристаллическом Ge при низкотемпературной деформации 38
- Дислокационная структура монокристаллов LiF в условиях резких термических изменений 1
- Дислокационная структура приповерхностных слоев Ge, обусловленная воздействием лазерного луча миллисекундной длительности 73

- Дислокації у приповерхневому шарі Ge, причинені лазерним імпульсом 92
- Дифузійний механізм формування кластерів у GaAs під дією просторово-періодичного лазерного опромінення 111
- Дифузійно-дислокаційна мікропластичність монокристалів Ge нижче температурної межі крихкого руйнування 120
- Дифузійно-дислокаційна мікропластичність монокристалів Ge нижче температурної межі крихкого руйнування 114
- Дифузійно-дислокаційна модель утворення періодичної структури на поверхні напівпровідника при імпульсному лазерному опроміненні 112
- Дія абразивних часток на поверхню монокристала у процесі хіміко-механічного полірування 93
- До методики вивчення електричних машин 45
- До теорії логарифмічної низькотемпературної повзучості, зумовленої виснаженням дислокацій 61
- Дослідження напівпровідників методом вимірювання вольт-фарадних характеристик 56
- Дослідження поверхневої міграції вакансій в напівпровідниках германію в осцилюючому полі механічних напружень 27
- Електротехніка 110
- Емоційний фактор у викладанні фізики 57
- З досвіду викладання фізики в ліцеї 48
- Зміст освіти і можливості НІТ 34
- Изменение времени жизни носителей заряда и проводимости дефектного приповерхностного слоя Ge при термообработках 87
- Измерение времени жизни носителей заряда и толщины дефектного поверхностного слоя полупроводника методом модуляции проводимости в точечном контакте 58
- Измерение диффузионной длины носителей заряда в приповерхностных слоях монокристалла германия 140
- Измерение параметров рекомбинации неравновесных носителей заряда в приповерхностных слоях монокристаллического Ge 127
- Измерение параметров рекомбинации неравновесных носителей зарядов в приповерхностных слоях монокристалла германия 124
- Измерение ЭДС Холла на переменных электрических и магнитных полях 2
- Измерения времени жизни неосновных носителей заряда в приповерхностном слое с дефектами монокристалла германия 116
- Измерения времени жизни неосновных носителей заряда в приповерхностном слое монокристаллического Ge зондовым методом 123
- Информатизация системы образования как условие совершенствования его содержания 30

Использование аналогий для создания проблемных ситуаций	42
Исследование дислокаций сканирующим электронным пучком	74
Исследование закономерностей низкотемпературной микропластической деформации монокристаллического германия и кремния	12, 13
Исследование микропластичности полупроводника InAs	71
Исследование наноструктур на поверхности монокристаллического Ge методом атомно-силовой микроскопии	128
Исследование поверхности деформированного Ge методом атомно-силовой микроскопии	131
Исследование распределения дефектов в полупроводниковых пластинах интегральных схем при воздействии механических напряжений	134
Исследование сферического p-n-перехода методом модуляции проводимости	41
Исследование электрических свойств Ge и Si, деформированных при низких температурах	66
Исследование электрических свойств полупроводников со структурой алмаза и сфалерита, деформированных при низких температурах	59
Компьютерное моделирование опытов Франка-Герца	63
Комп'ютерне моделювання в навчальному процесі	46
Комп'ютерне моделювання досліду Франка-Герца	53
Комп'ютерне синтезування дифракційних масок	115
Комп'ютерне тестування як елемент процесу навчання	64
Логарифмическая ползучесть поликристаллической меди	50
Логарифмическая ползучесть при ступенчатом нагружении	51
Математическое моделирование низкотемпературной пластической деформации	55
Методика викладання теми "Просторова когерентність"	28
Микропластичность и электрические свойства Ge и Si, деформированных при низких температурах	75
Микропластичность и электрические свойства алмазоподобных полупроводников, деформированных при низких температурах	72
Микропластичность монокристаллов Ge при воздействии лазерного облучения и деформации сжатия	88
Микропластичность приповерхностных слоев алмазоподобных полупроводников	76
Мікропластичність алмазоподібних кристалів (Si, Ge, GaAs, InAs)	105
Мікропластичність алмазоподібних кристалів	106
Мікропластичність у кристалах GaAs	94
Наукова робота студентів як елемент навчального процесу	60

Неконсервативное движение ростовых дислокаций в макрообразцах и нитевидных кристаллах Ge и Si в условиях одноосного сжатия при 20° С 17

Некоторые закономерности ступенчатой ползучести монокристаллического германия при 300 К 6

Некоторые закономерности ступенчатой ползучести монокристаллического германия и кремния при комнатной температуре 3

Некоторые механизмы разрушения ковалентных кристаллов при пониженных температурах 117

Низкотемпературная деформация в монокристаллах Ge и Si 16

Низкотемпературная микропластичность кристаллов InAs 77

О закономерностях пластической деформации кремния при комнатной температуре 7

О механизме упрочнения приповерхностного слоя германия под действием низкотемпературной циклической деформации 107

О низкотемпературной ступенчатой ползучести кристаллических тел как фрактальном физическом процессе 29

О пластической деформации Ge и Si при комнатной температуре в условиях одноосного сжатия 14

О пластической деформации германия и кремния при комнатной температуре в условиях одноосного сжатия 4

О пластической деформации германия при комнатной температуре 8

О применимости методик определения параметров рекомбинации носителей заряда к приповерхностным слоям полупроводника 118

О применимости теории упрочнения к описанию единства закономерностей деформирования в различных условиях одноосного растяжения 5

О роли диффузионных механизмов в процессе релаксации напряжений на концентраторах в монокристаллическом германии 119

Об эффективности использования проблемного обучения на подготовительном отделении 23

Образование наноструктур на поверхности германия при деформировании в температурном интервале (300-600) К 129

Особенности микропластической деформации германия в условиях одноосного сжатия при комнатной температуре 15

Особенности низкотемпературной микропластической деформации германия в условиях одноосного сжатия 10

Особенности низкотемпературной микропластической деформации кремния при комнатной температуре 11

Получение низкоразмерных структур на поверхности монокристаллического германия низкотемпературным деформированием 125

Про вдосконалення змісту шкільної фізичної освіти 39

Про рекомбінацію нерівноважних носіїв заряду у дефектному поверхневому шарі монокристалічного Ge 67



- Про фізичний механізм виникнення дислокацій у приповерхневих шарах Ge під дією лазерного опромінювання мілісекундної тривалості 78
- Про фізичний механізм виникнення дислокацій у приповерхневих шарах Ge під дією лазерного опромінювання мілісекундної тривалості 95
- Про формування наукового світогляду в сучасних умовах у студентів фізико-математичного факультету при вивченні фізики 47
- Проблемы современных образовательных технологий 65
- Психологические основы творчества и проблемное обучение 24
- Пути реализации проблемного обучения на лекциях 22
- Распределение дефектов в тонких полупроводниковых пластинах при низкотемпературной деформации 138
- Распределение термоупругих напряжений по облучаемой лазерным импульсом поверхности монокристаллов GaAs 113
- Расчет дислокационных донорных уровней в щелочно-галогидных кристаллах на основе экспериментальных данных о низкотемпературной ползучести 21
- Рентгеновские исследования дефектов структуры в приповерхностных слоях монокристаллов германия и кремния, деформированных при 310 К 81
- Розрахунок термопружних полів у кристалах GaAs, спричинених дією лазерного променя з дифракційною просторовою модуляцією 96
- Розрахунок термопружних полів у кристалах GaAs, спричинених дією лазерного променя з дифракційною просторовою модуляцією 97
- Рух дислокацій у напівпровідниках, спричинений градієнтом напружень 82
- Свойства наноструктур, сформированных на поверхности Ge диффузионным массопереносом 141
- Система підготовки майбутнього вчителя фізики 35
- Сопротивление двухслойной полупроводниковой структуры в процессе инъекции через точечный контакт 32
- Спосіб визначення міри дефектності приповерхневих шарів монокристалів германію або кремнію 133
- Спосіб створення наноструктур на поверхні германію 139
- Стимулированная напряжением поверхностная диффузия и ее влияние на нарушение монокристаллов Ge 136
- Структурні зміни у приповерхневому шарі Ge під дією лазерного імпульсу 83
- Структурно-кинетические закономерности движения дислокаций в монокристаллах Ge и Si в низкотемпературном интервале 20-300 К 18
- Структурные изменения в зоне действия лазерного луча в монокристаллическом германии 84
- Структурные изменения в кристаллах GaAs, деформированных сжатием при 300 К 89

Ток в точечном контакте полупроводника с дефектным поверхностным слоем 25

Установка для исследования микропластичности полупроводниковых кристаллов 90

Установка для исследования ползучести алмазоподобных полупроводниковых материалов при комнатной температуре 9

Устройство для измерения параметров рекомбинации неравновесных носителей заряда в приповерхностных слоях монокристаллов Ge 130

Утворення періодичних структур у приповерхневих шарах GaAs під дією імпульсного лазерного опромінення 98

Фізика як засіб гуманітаризації освітньо-професійній підготовці вчителя технологій 43

Фізика як засіб гуманітаризації освітньо-професійної підготовки вчителя технологій 44

Фізика як засіб гуманітаризації освітньо-професійної підготовки вчителя технологій 49

Формирование массивов наноструктур на поверхности германия при создании градиента напряжения 137

Формирование наноструктур в Ge при условии дислокационно-поверхностной диффузии 132

Формування наноструктур у монокристалічному германії за умови дислокаційно-поверхневої дифузії 135

Численный эксперимент в радиоэлектронике 31

Шляхи гуманітаризації викладання фізики 36

Электрические свойства кремниевых p-n-переходов с дислокациями, созданными низкотемпературной деформацией 54

Analysis the relief of the GaAs surface formed upon exposure to diffraction-modulated laser radiation 109

Formation of Defect in Ge Subsurface Layers under the Action of Laser Pulse 79

Formation of periodic structures in GaAs near-surface layers irradiated by laser pulse 101

Investigation of Dislocation in Ge single crystals by scanning Electron beam 91

Microplasticity and Electrical Properties of Subsurface Layers of Diamond-like Semiconductors Deformed at Low Temperatures 85

Microplasticity of subsurface layers of diamond-like semiconductors under microindentation 100

Periodic structure formation in GaAs near – surface layer by laser beam with diffraction modulated intensity 104

Pneumatik pendulum 40

Recombination of non-equilibrium charge carriers injected into Ge through intermediate defective layer 102

Structure Changes Caused by the Stress Gradient in Subsurface Layers of Germanium Single Crystals 86

Structure changes caused by the stress gradient in subsurface layers of germanium single crystals 80

## Зміст

Від упорядників.....	4
Безкомпромісні пошуки наукової істини.....	5
Основні дати життя та діяльності В. О. Надточія.....	8
Розділ I. Праці В. О. Надточія.....	9
Розділ II. Наукова школа вченого В. О. Надточія.....	26
Розділ III. Література про життя та діяльність.....	27
Допоміжні покажчики	
Іменний покажчик.....	28
Алфавітний покажчик праць В. О. Надточія.....	30